

**96-0299**

Изобретение относится к полупро–водниковой технологии и может быть использовано для получения мате–риалов полупроводниковой электро–ники.

Способ получения многослойных эпитаксиальных структур включает последовательное выращивание эпи–таксиальных слоев, содержащих различные компоненты, в соответ–ствующем газовом потоке, после вы–ращивания каждого слоя его обво–лакивают потоком неактивного газа до выращивания следующего слоя.

Установка для получения много–слойных эпитаксиальных структур включает реактор с камерами для выращивания эпитаксиальных слоев, соединенных штоком, узел крепления подложек, механизм приведения в действие камер для выращивания эпитаксиальных слоев. Узел для крепления подложек выполнен в виде полок, размещенных в трубках, рас–положенных одна над другой на расстоянии, не превышающем мини–мальную диффузионную длину мо–лекул используемого газа.

Технический результат заключается в обеспечении возможности получения эпитаксиальных многослойных структур с резким профилем.

П. формулы: 2

Фиг.: 4